



2026年5月29日

各 位

会 社 名 三菱電機株式会社
代 表 者 名 執行役社長 漆間 啓
(コード番号 6503 東証プライム市場)
問 合 せ 先 広報部長 高橋 真倫子
(TEL 03-3218-2111)

三菱電機 IR Day 2026 説明会資料（半導体・デバイス事業）公開のお知らせ

当社は、5月29日（金）10時30分から、機関投資家・証券アナリストおよび報道関係者を対象に開催する「IR Day 2026」の説明会資料を公開しますので、お知らせします。

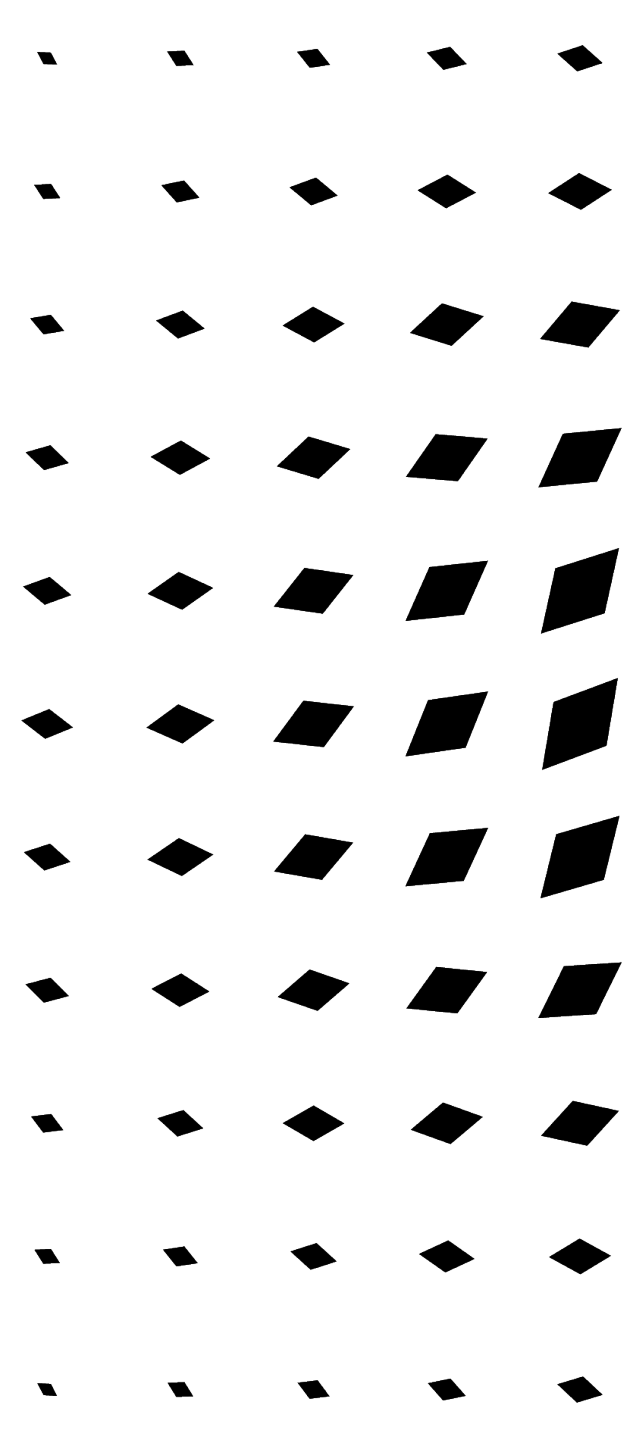
別添資料：三菱電機 IR Day 2026（半導体・デバイス事業）

✍

半導体・デバイス事業 2026

三菱電機株式会社

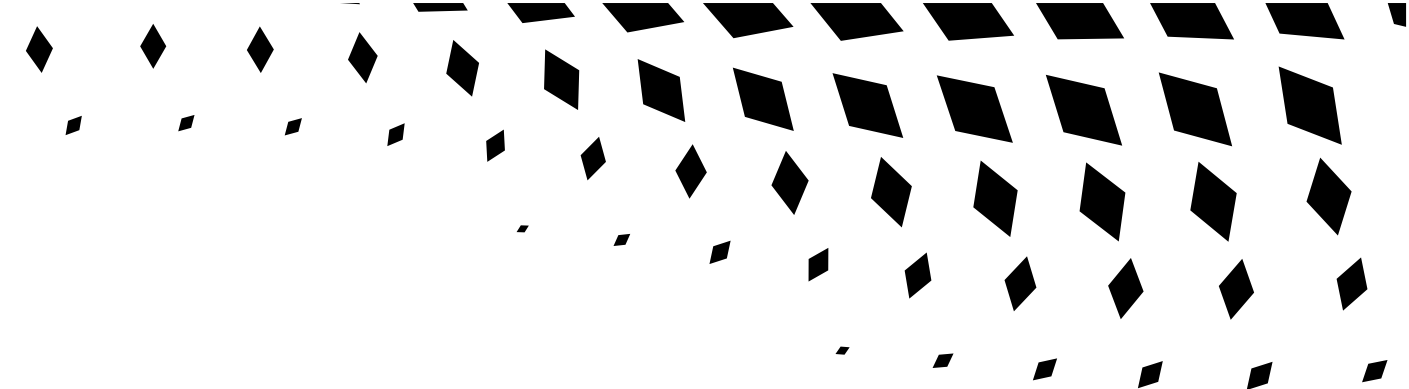
2026/05/29



目次

1. 半導体・デバイス事業 新中期事業戦略	3
2. ターゲット領域	5
3. 重点施策	8
4. 財務目標 及び 関連指標	12

1



半導体・デバイス事業 新中期事業戦略

半導体・デバイス事業 新中期事業戦略

パワーデバイスのポートフォリオ最適化、光デバイスの市場リーダーシップ強化により、成長を加速
収益性・生産性を追求した抜本的な資本効率改善により、持続的成長を実現

重点施策

パワーデバイス事業

高付加価値領域の拡大を通じた事業ポートフォリオ最適化

- 高耐圧(HV*1)分野のラインアップ強化と供給体制強化
- 民生・データセンター電源等の分野へのSiC適用拡大

高周波・光デバイス事業

データセンター向け光デバイス事業の圧倒的地位の堅持と次世代展開

- 超高速EML*2チップの開発加速と供給体制の拡充
- CPO*3市場立ち上がりと次世代化を見据えたラインアップ強化

共通

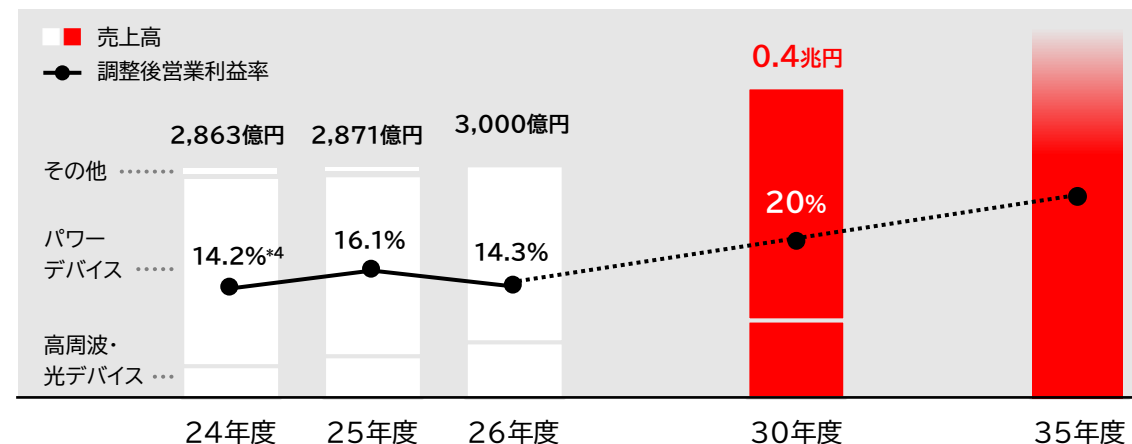
収益性・生産性追求による資本効率改善

- プロダクトミックス転換、バリューチェーン最適化

30年度財務目標

	売上高	調整後営業利益率
半導体・デバイス事業	0.4兆円	20%

売上高・調整後営業利益率



*1 HV(High Voltage) : 高耐圧 *2 EML(Electro-absorption Modulator integrated Laser diode) : 電界吸収型光変調器を集積した半導体レーザーダイオード
*3 CPO(Co-Packaged Optics) : 光電融合の実装形態 *4 営業利益率(24年度のみ)

2

ターゲット領域

ターゲット領域・市場・トレンド | パワーデバイス

カーボンニュートラル、低消費電力化を背景に、パワーデバイス市場は中長期的に拡大
長年培った高耐圧・高信頼性技術を活かし、社会インフラの進化に貢献

中期市場環境

★ … ターゲット領域

★ 電鉄・電力	<ul style="list-style-type: none">● HVDC*1市場の持続的成長● 電鉄市場のSiC需要拡大
★ 産業・再エネ・電源	<ul style="list-style-type: none">● 太陽光発電・エネルギー貯蔵システム市場のSiC需要拡大● データセンター電力の需要増加に伴う高効率電源市場の拡大
★ 民生	<ul style="list-style-type: none">● 省エネ規制強化に伴う業務用・家庭用エアコン市場のSiC需要拡大
自動車	<ul style="list-style-type: none">● 市場拡大を牽引の一方、BEV*2シフトは減速● プレーヤー増加による価格競争激化

当社のポジション・強み

**豊富な市場実績と技術基盤を武器に、
社会インフラを支える高耐圧・高信頼性分野を牽引**

【パワーモジュール グローバルシェア 2位*3】

- **高い性能・品質を実現するチップ技術とモジュール技術**
 - SBD*4 内蔵 SiC-MOSFET*5 モジュール Unifull™シリーズによる高耐圧領域における低損失化（従来 Si パワーモジュール比 91%低減）
 - 高精度なスクリーニング技術による高信頼性実現
- **豊富な市場実績と高付加価値領域でグローバルトップシェア**
 - IPM (Intelligent Power Module) : グローバルシェア 1位*3
 - VSC*6型HVDC向けパワーモジュール : グローバルシェア 1位*7
- **長年の市場リーダーシップに裏打ちされた強固な顧客基盤**
 - 高耐圧分野においてグローバルリーダー（主要メーカー・研究機関）との協定締結

*1 HVDC(High Voltage Direct Current) : 高圧直流送電 *2 BEV(Battery Electric Vehicle) : 電気自動車 *3 出典: OMDIA, Power Semiconductor Market Share Database-2H25(24年実績)

*4 SBD(Schottky Barrier Diode) : ショットキーバリアダイオード *5 MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) : 金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ

*6 VSC(Voltage Sourced Converter) : 自励式交流直流変換器 *7 24年度実績、当社調べ

ターゲット領域・市場・トレンド | 高周波・光デバイス

AI関連投資の継続を背景に、データセンター市場の急成長と次世代化が加速
トップシェアの超高速光デバイスを核に、高付加価値領域における成長を牽引

中期市場環境

★ … ターゲット領域

光デバイス

★ データセンター	<ul style="list-style-type: none">● AI関連投資の継続による需要拡大● 超高速化・低消費電力化のニーズ拡大
アクセスネットワーク	<ul style="list-style-type: none">● 50G-PON*1の導入● モバイルフロントホールの高速化

高周波デバイス

★ 防衛・宇宙	<ul style="list-style-type: none">● 防衛費増額に伴う防衛システム事業の拡大
モバイル基地局	<ul style="list-style-type: none">● 5G-Advanced/6G技術の発展

当社のポジション・強み

生成AI市場の拡大を牽引する超高速光デバイスにおいて 圧倒的地位を確立

【データセンター向けEMLチップ グローバルシェア 1位*2】

● 化合物半導体の高度な製造技術・ノウハウ

- データセンター向けEMLチップ : 累計 1億個出荷 (25年度)
- 5G基地局用GaNモジュール : 累計 300万個出荷 (25年度)
- 高度な化合物半導体コア技術を基盤に、今後成長が見込まれる宇宙・量子・センシング分野へ事業領域を拡大し、新たな収益源となる新規事業を創出

● 市場をリードするグローバルトップ企業との強固なパートナーシップ

- データセンター向けEMLチップ : グローバルシェア 1位*2
- ハイパースケーラーやネットワークシステムサプライヤーを含む多層的かつ盤石な顧客基盤

● 防衛システムにおけるデバイスからシステムまでの垂直統合開発

- 複雑・高度化する防衛システムの要求に対応した柔軟なデバイス開発・製造

*1 50G-PON(50 Gigabit Passive Optical Network) : 最大下り50Gbps級の通信速度を実現する次世代光アクセス方式

*2 データセンター向け光デバイスのグローバルシェア1位(データセンター向けEMLチップにおける24年度実績、当社調べ)

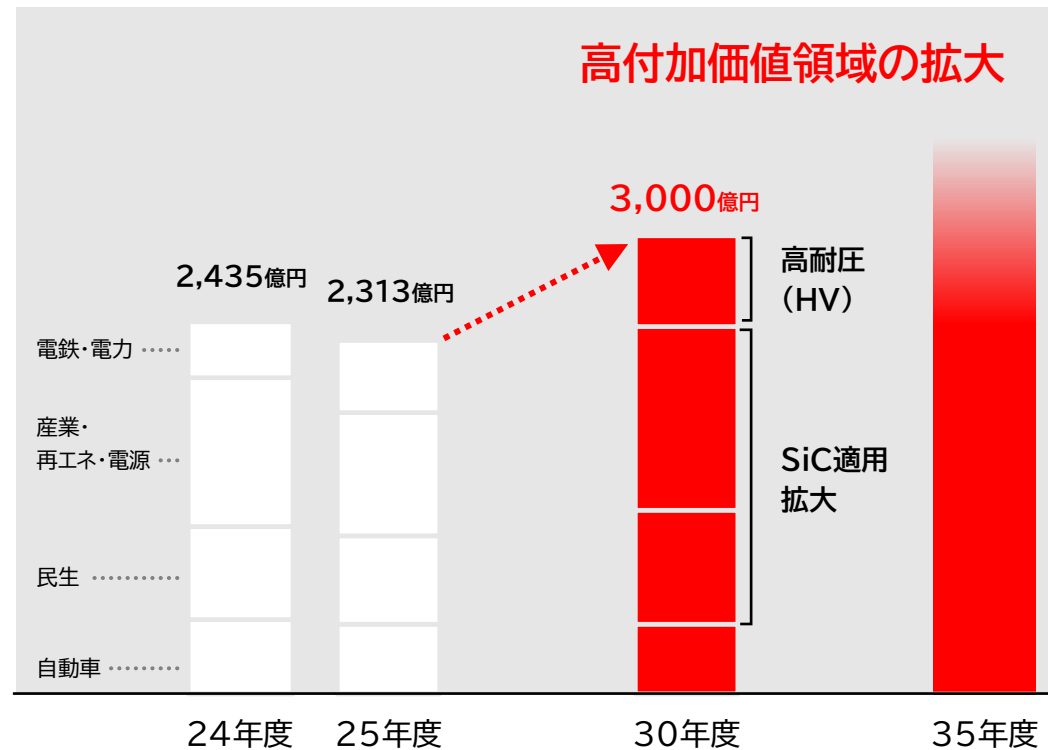
3

重点施策

高付加価値領域の拡大による事業ポートフォリオ最適化 | パワーデバイス

HVDC市場の持続的成長と民生・新分野へのSiC適用拡大により、高付加価値領域を拡大
当社の強みが生きるインフラ分野を軸に、バランスの取れたポートフォリオにより持続的成長を実現

分野別売上高



重点施策

HVDC市場の持続的成長を取り込み、強みを活かした高耐圧(HV)製品での圧倒的シェア堅持

- 製品ラインアップ強化：低損失かつ高耐圧・大電流IGBT*1の先行開発
- 供給体制強化：生産能力増強(23年度→27年度：2.3倍)に加え、新工場棟(福岡地区)へのHVライン新設による生産効率向上(27年度以降)

SiC製品のラインアップ拡充とコスト競争力強化

- チップ技術の強化によるSiC適用分野拡大
 - 業務用・家庭用エアコン分野のSiCラインアップ拡大 (SLIMDIP*2パッケージ：25年度量産化、Compact DIPIPM*2：27年度量産予定)
 - データセンター電源等の新市場におけるSiC需要拡大を踏まえた 超高耐圧化・高信頼性・低ノイズ化等のニーズ対応
- 垂直連携によるコスト競争力強化：米Coherent社との連携及び新工場棟(熊本県泗水地区)立ち上げにより、SiCの8インチ化とコスト競争力強化を加速

*1 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)：絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ *2 SLIMDIP、DIPIPM：三菱電機株式会社の商標

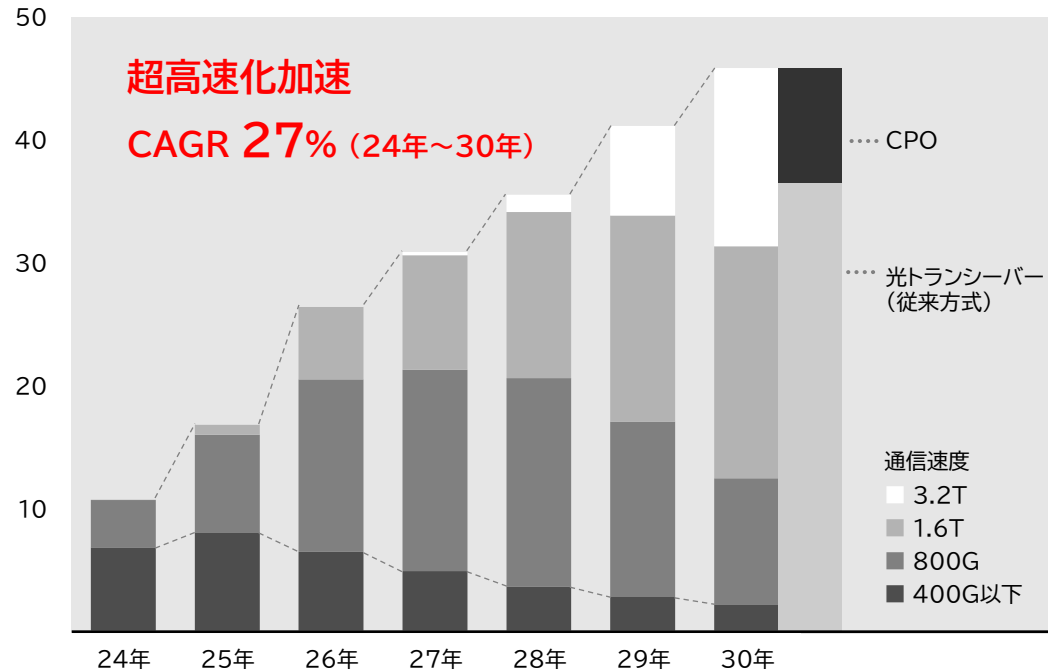
データセンター向け圧倒的地位の堅持と次世代展開 | 高周波・光デバイス

AI需要の爆発的拡大を背景に、EMLチップの生産能力を29年度までに25年度比で3倍超へ増強(20年度比20倍)

超高速EMLチップにおける圧倒的シェアを堅持するとともに、次世代CPO向け光デバイス開発により中長期の成長を加速

Ethernet*1光トランシーバー+CPO市場

(10億USD)

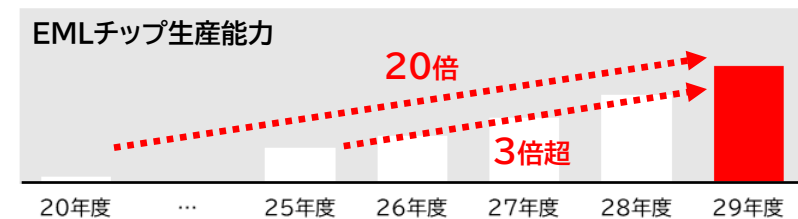


出典: LightCounting Optics for AI Forecast, January 2026

重点施策

次世代EMLチップの先行開発と、戦略的増産体制構築によるグローバルトップシェア堅持

- 先進的な光デバイス開発: 業界トップ企業のニーズに最適化したEMLチップの開発
- 設備投資による生産能力増強: 25年度に400億円の投資を決定し、29年度までに25年度比で3倍超へ増強(20年度比20倍)



InP技術の優位性を活かした次世代CPOの牽引

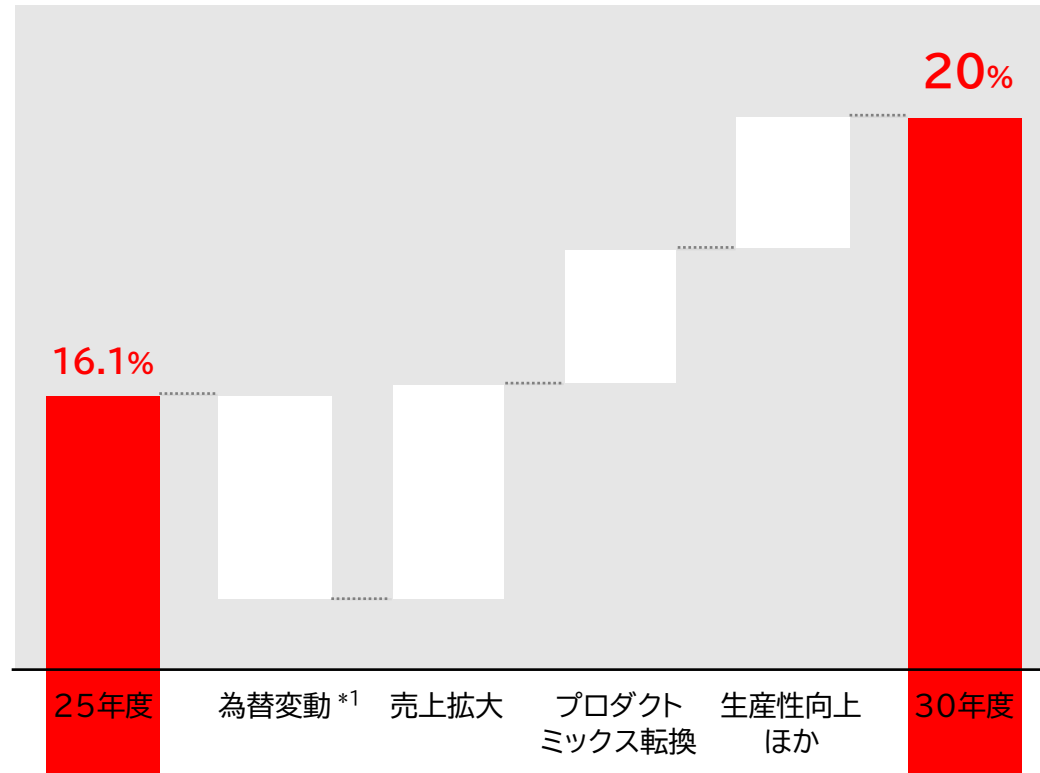
- 次世代CPO向け光デバイス開発: InP*2半導体技術を活用したCPO向けCW*3光源と変調器デバイスの市場投入

*1 Ethernet: 家庭・企業・データセンターなどで使用される有線ローカルエリアネットワークの主流な通信規格 *2 InP(Indium Phosphide): リン化インジウム *3 CW(Continuous Wave): 連続波

収益性・生産性追求による資本効率改善 | 共通

プロダクトミックス転換とバリューチェーン最適化を図り、30年度に調整後営業利益率20%(ROIC12%)を目指す

調整後営業利益率



重点施策

高付加価値領域へのプロダクトミックス転換

- キャピタルアロケーションの最適化：パワーデバイス事業への先行投資に一定のめどをつけ、光デバイス事業への成長投資を加速
- 高付加価値領域の成長加速：高耐圧(HV)製品、データセンター電源等の新分野向けSiC、光デバイスの売上拡大

バリューチェーン最適化による生産性向上

- サプライチェーン改善：大口顧客向けの物流ルート刷新・在庫管理の適正化による製造から納入までのリードタイム短縮(棚卸資産の適正化)
- 製造工程の生産性向上：ウエハプロセス工程(熊本県泗水地区)とモジュール組立・検査工程(福岡地区)の新工場棟活用による生産効率改善
- グローバル販売体制の再編：拠点や組織体制の集約・最適化による営業効率向上
- 間接業務の効率化：AI・DXを活用した業務改革推進等による人的リソースの最適配置と生産性向上

*1 25年度: 151円/US\$, 176円/Euro, 21.4円/人民元
30年度: 140円/US\$, 160円/Euro, 19.5円/人民元

4

財務目標 及び 関連指標

財務目標・関連指標

財務目標

	25年度実績				26年度見通し			30年度目標		
	売上高 (億円)	調整後 営業利益 (億円)	調整後 営業利益率	ROIC	売上高 (億円)	調整後 営業利益 (億円)	調整後 営業利益率	売上高	調整後 営業利益率	ROIC
半導体・デバイス事業	2,871	463	16.1%	8.6%	3,000	430	14.3%	0.4兆円	20%	12%
	151円/US\$ 176円/Euro 21.4円/人民元				150円/US\$ 175円/Euro 21.5円/人民元			140円/US\$ 160円/Euro 19.5円/人民元		

関連指標

	25年度実績	26年度見通し	30年度目標
パワーデバイス事業 売上高(億円)	2,313	2,270	3,000
高周波・光デバイス事業 売上高(億円)	554	730	1,000

ローム、東芝D&Sとのパワー半導体事業・経営統合に関して

グローバル競争が激化する中、従来の国際連携を通して競争優位性を堅持しつつ、さらなる競争優位性を築くことを目指し、グローバル市場で競争し得る事業規模と技術基盤を実現するための協議を開始

各社の総合力を結集し、パワー半導体のグローバルリーディングプレイヤーとしての地位を確固たるものに



MITSUBISHI
ELECTRIC



TOSHIBA

15位*1

パワー半導体モジュール
グローバルシェア **2位***1

17位*1

12位*1

パワー半導体
(モジュール+ディスクリート)
グローバルシェア **4位***1

10位*1

激化するグローバル競争への対応

- 中国競争の台頭：中国国内の垂直統合モデルによる圧倒的コスト競争力
➡ 米Coherent社からの**高品質な8インチSiC基板の安定的調達**を通して、**SiCパワーデバイスのコスト競争力を強化**
- 欧米競争の伸長：欧米競争の全方位戦略によるグローバルシェア拡大
➡ 蘭Nexperia社との国際連携を通して、**SiCディスクリート市場に対するアクセスを強化**

パワー半導体事業・経営統合の狙い

- さらなるパワーデバイス事業の競争優位性を築くことを目指して、**各社パワー半導体の総合力を結集し、事業・開発シナジーを最大限に発揮**
- グローバル市場で競争し得る事業規模と技術基盤を実現し、**我が国の半導体事業として幅広い顧客層と広範な産業分野の発展に大きく貢献**

*1 出典: OMDIA, Power Semiconductor Market Share Database-2H25(24年実績)

本資料に記載されている三菱電機グループの業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点において合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は見通しと大きく異なることがあります。

なお、業績等に影響を及ぼす可能性がある要因のうち、主なものは以下のとおりですが、新たな要因が発生する可能性もあります。

- ① 世界の経済状況・社会情勢及び規制や税制等各種法規の動向
- ② 為替相場
- ③ 株式相場
- ④ 資金調達環境
- ⑤ 製品需給状況及び部材調達環境
- ⑥ 重要な特許の成立及び実施許諾並びに特許関連の係争等
- ⑦ 訴訟その他の法的手続き
- ⑧ 製品やサービスの品質・欠陥や瑕疵等に関する問題
- ⑨ 地球環境(気候関連対応等)等に関連する法規・規制や問題
- ⑩ 人権に関連する法規・規制や問題
- ⑪ 急激な技術革新や、新技術を用いた製品の開発、製造及び市場投入時期
- ⑫ 事業構造改革
- ⑬ 情報セキュリティ
- ⑭ 地震・津波・台風・火山噴火・火災等の大規模災害
- ⑮ 地政学的リスクの高まり、戦争・紛争・テロ等による社会・経済・政治的混乱
- ⑯ 感染症の流行等による社会・経済・政治的混乱
- ⑰ 当社役員・大株主・関係会社等に関する重要事項

